

III. ORIGIN OF PINNED BURIED PHOTODIODE

Pinned Buried Photodiode shown in Figure 7
in JPA1975-127647 filed on October 23, 1975

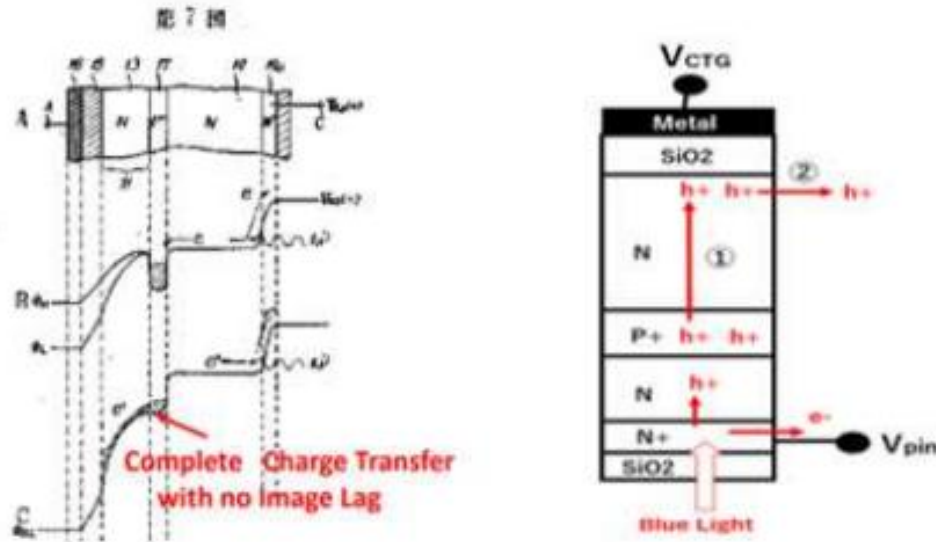


Fig 6 A reproduction of Patent Claim and a figure in JPA1975-127647

Pinned Buried Photodiode invented by Yoshiaki Hagiwara
as defined in Japanese Patent Claim of
JPA1975-127647 filed on October 23, 1975

特許請求の範囲

半導体基体の一方の主面側に、絶縁膜を介して電荷転送用電極が被覆配列される1の導電型の転送領域が形成され、之より上記半導体基体の他方の主面側に上記転送領域に接する他の導電型の領域と被覆領域に接する1の導電型の領域とより成る受光領域が形成され、上記転送用電極に所定の電圧を印加することにより、上記受光領域に蓄積した電荷を上記転送領域に転送し、上記電荷転送用電極に上記所定の電圧とは異なるクロス電圧を印加して上記基体の上記一方の主面に合つて電荷の転送を行うようにしかことを特徴とする固体撮像装置。

Pinned Buried Photodiode shown in Figure 7
in JPA1975-127647 filed on October 23, 1975

[6] http://www.aiplab.com/JPA_1975_127647_on_NPN_type_PPD.html